

### 关键指标

射频&本振频率：24~40GHz  
中频频率：DC~6GHz  
本振功率：13dBm  
变频损耗：9dB  
LO/RF 隔离度：30dB  
芯片尺寸：0.7mm×1.05mm×0.1mm

### 产品简介

HG128HB 是一款无源双平衡混频器芯片，射频和本振频率为 24~40GHz，中频频率为 DC~6GHz，变频损耗为 9dB。

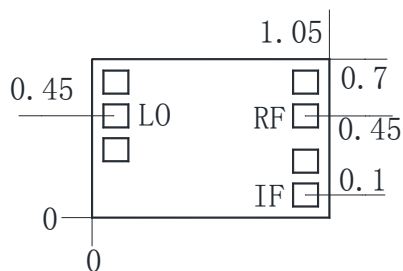
### 电性能 (T<sub>A</sub>=25℃)

指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率(GHz)	24~40		
IF 频率(GHz)	DC~6		
变频损耗(dB)	—	9	—
LO~RF 隔离度(dB)	—	30	—
LO~IF 隔离度(dB)	—	35	—
RF~IF 隔离度(dB)	—	15	—

### 绝对额定最大值

最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

### 外形和端口尺寸 (mm)



### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。